

a 2005 0253

Invenția se referă la materialele semiconductoare și poate fi utilizată pentru obținerea aliajelor semiconductoare. Esența invenției, conform primei variante, constă în aceea că aliajul este executat în bază de Bi dopat cu Te și tratat termic până la recristalizare, gradientul de temperatură al căruia este orientat de-a lungul axei trigonale a rețelei cristaline a aliajului, unde Te se conține în proporție de 1,35...1,45% at. Conform variantei a doua, gradientul de temperatură al aliajului este orientat de-a lungul axei bisectoare a rețelei sale cristaline, unde Te se conține în proporție de 1,05...1,15% at.

Revendicări: 2

Figuri: 1